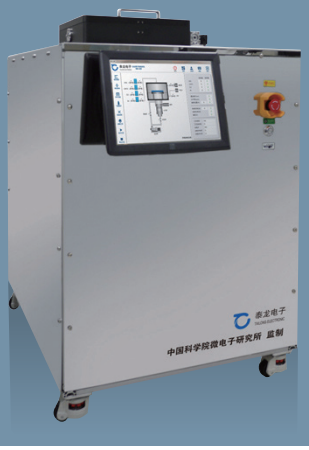
高密度等离子体刻蚀机

High Density Plasma Etching System

ICP-100



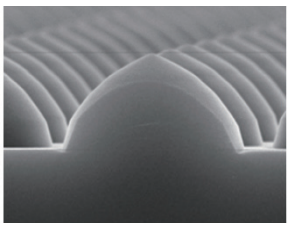
主要技术与性能指标

- 刻蚀速率：Si，≥ 0.5 μm/min；SiO_2，≥ 0.2 μm/min
- 刻蚀材料：石英、蓝宝石、硅
- 非均匀性：4 英寸样片，≤ ±5%
- 气路系统：标配 6 路进气，可定制

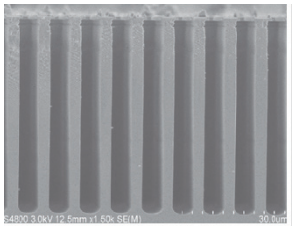
主要应用

用于微电子、光电子器件的刻蚀

代表性应用成果



0.5 μm 蓝宝石图形刻蚀



高深宽比深硅刻蚀



多阶光栅刻蚀

主要用户单位	清华大学、北京大学、天津大学、中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心
研制单位	中国科学院微电子研究所、泰龙电子技术有限公司
联系方式	何　萌　010-62049399，13581817539　hemeng@ime.ac.cn